Vol. 42, No. 9 September, 2012

文章编号:1001-5078(2012)09-0986-03

·激光器技术·

可调谐中红外 OPO 激光器研究

包照日格图,张大勇,冯宇彤,张利明 (固体激光技术重点实验室,北京 100015)

摘 要:研究了一种中红外可调谐 OPO 激光器,泵浦源为输出能量 200 mJ 能量的 1.06 μm Nd: YAG 激光器,OPO 采用 XZ 平面内二类匹配的 KTP - OPO,实现了信频光 1.5~2.0 μm、闲 频光 2.3~3.6 μm 的波长调谐,光光转换效率 10% 以上。

关键词:中红外激光;可调谐 OPO;KTP 晶体

中图分类号:TN244 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001-5078.2012.09.005

Research on tunable mid-infrared OPO laser

BAO Zhao-ri-ge-tu, ZHANG Da-yong, FENG Yu-tong, ZHANG Li-ming (Science and Technology on Solid-State Laser Laboratory, Beijing 100015, China)

Abstract: Presented in this paper is the study of a mid-infrared tunable OPO laser with a pump source of 200 mJ, 1.064 μ m Nd: YAG laser. The OPO uses type two matching KP-OPO in XZ plane. Signal-frequency of 1.5 ~ 2.0 μ m and idler frequency of 2.3 ~ 3.6 μ m are obtained. The wavelength is continuously tunable. The light to light conversion efficiency is better than 10%.

Key words: mid-infrared laser; tunable OPO; KTP crystal

1 引 言

光参变振荡器(OPO)提供了从可见到红外的 可调谐相干辐射,已广泛应用于激光同位素分离、燃 烧诊断、大气污染的遥测、光雷达等方面[1-2]。在军 事应用领域连续宽调谐中波红外激光辐射源可作为 干扰源使用,国外已经开始研发并有一些产品问世。 可调谐激光器的种类很多,主要分终端声子固体激 光器、色心激光器、染料激光器及光参量振荡器。由 于光参量振荡器方法可以实现较宽范围的调谐激光 输出,因此它成为现今的研究热点,如德国 GWU 公 司研发的 spitscan 200/IR,英国 M Suared laser 公司 的 firefly IR - OPO。国内四川大学^[3]也进行该方面 的理论研究。我们采用了高峰值功率1064 nm 激光 泵浦的角度调谐 KTP - OPO,实现了信频光 1.5~ 2.0 μm、闲频光 2.3~3.6 μm 的连续波长调谐,转 换效率 20%,脉宽 18 ns,为相关领域的研究奠定了 基础。

2 理论设计

2.1 低振荡阈值 OPO 设计

对于宽调谐 OPO 激光器来讲要实现它的高效 运转,其泵浦功率密度至少为阈值的 4 倍以上^[4]。 所以在有限的泵浦强度下尽量降低 OPO 阈值是关 键所在。

对于单程泵浦方式,OPO 的阈值可以描述为:

$$I_{\rm th} = \frac{1.12}{kg_s l_{\rm eff}^2} \left(\frac{L}{t_p c} \ln \frac{p_s}{p_n} + 2\alpha l + \ln \frac{1}{\sqrt{R}} + \ln 2 \right)^2 \quad (1)$$

$$k = \frac{8\pi^2 d_{\rm eff}^2}{\lambda_s \lambda_i n_s n_i n_p \varepsilon_0 c} \tag{2}$$

$$l_{\rm eff} = \frac{\sqrt{\pi\omega_p}}{2\rho} \tag{3}$$

收稿日期:2011-10-27;修订日期:2012-04-12

作者简介:包照日格图(1974-),男,硕士,副研究员,主要从事 全固态激光器技术和光参量振荡器技术研究。E-mail:baokun2008@ sina.com

其中,k 为耦合常量; g_s 为模式耦合系数(阈值附近 约0.85); l_{eff} 为有效增益长度;L 为光学腔长; t_p 为基 频光的脉冲宽度;R 为 OPO 的输出耦合率。理论计 算表明对阈值影响最大的因素就是有效的参量增益 长度 l_{eff} 的平方和晶体的非线性系数 d_{eff} 的平方。晶 体的非线性系数 d_{eff} 越大 OPO 的阈值就会越低越容 易起振,晶体的双折射走离角越小,有效的增益长度 就越长,越有利于降低 OPO 阈值,进而提高 OPO 转 换效率。表 1 是适合调谐 OPO 的三种晶体的性能 差别。

表 1	几种适	用于	中红	外可订	周谐	OPO
-----	-----	----	----	-----	----	-----

	LN	КТР	КТА
有效非线性系数/(pm・V ⁻¹)	3.5	2.5	2.5
走离角/mrad	50	35	40
损伤阈值/(MW・cm ⁻²)	100	500	500

激光的非线性晶体

非线性系数最大的晶体是 LN 晶体但该晶体的 损伤阈值较低不利于高峰值功率激光的泵浦的应 用,走离角最小的晶体是 KTP 晶体有利于增加有效 增益长度并且非线性系数也不低,最终选用了 KTP 晶体作为 opo 工作物质。图1 是利用振荡阈值的表 达式(1)计算得到的 OPO 阈值与晶体长度之间的关 系曲线,可以看到随着晶体长度的增加 OPO 阈值明 显下降,最终选定的晶体长度是 50 mm。



Fig. 1 the value of the crystal length and OPO threshold

2.2 角度调谐 KTP - OPO 设计

目前实现宽波段调谐的方法主要有温度调谐和 角度调谐,其中温度调谐简单方便但精度不够、调谐 速度慢、可适用的晶体很少(如 LN),考虑到 LN 晶 体的抗激光损伤能力较低的原因,本项目中未采用。 角度调谐是我们采用的技术路线,难点是要尽量减 少插入损耗同时在尽量小的调谐角度范围内实现宽 波段调谐。

晶体中传播的三个光波达到相位匹配时应满足

动量守恒($\Delta k = 0$),即:

$$\frac{n_s}{\lambda_s} + \frac{n_i}{\lambda_i} = \frac{n_p}{\lambda_p} \tag{4}$$

其中, λ_s , λ_i , λ_p 分别代表信频光、闲频光、基频光; n_s , n_i , n_p 代表信频光、闲频光、基频光的折射率。图 2 是根据 KTP 晶体的色散方程结合相位匹配条件 (公式(4))仿真计算出来的 XZ 平面内调谐曲线, 可以看出调谐曲线的简并点在 52°左右,从45°~48° 及 56°~77°都可以实现 1.5~2.0 µm 的调谐。 56°~77°角度范围内调谐因为调谐角度范围过大 (约 20°)将会导致插入损耗的增加不适合实现稳定 的宽调谐激光输出。45°~48°调谐虽然非线性稍微 小了一些(约 2.5 PM/V)但调谐角度范围较窄、插 入损耗较小,是最终的方案选择。



3 实验装置

根据上面理论分析进行了相关的方案设计,具体的光路图如图3所示。



其中,基频光为输出能量约 200 mJ、脉冲宽度 8 ns、 光束发散角 1 mrad 的 Nd:YAG 激光器;OPO 由两块 走离补偿的 KTP 晶体、M1 镜片、M2 镜片组成,M1 镜片对基频光高透过、对信频光(1.5~2.0 µm)高 反射、对闲频光(2.3~3.6 µm)高反射;M2 镜片对 信频光(1.5~2.0 µm)部分反射、对闲频光(2.3~ 3.6 µm)高透过、对基频光高透过;SP1 对基频光高 反射、信频光(1.5~2.0 µm)高透过、闲频光(2.3~ 3.6 µm)高透过;SP2 对信频光(1.5~2.0 µm)高透 过、对闲频光(2.3~3.6 µm)高反射。OPO 的工作 介质为 XZ 平面内二类匹配的 KTP 晶体,两块 KTP 晶体的晶轴互为反向,以形成走离补偿,切割角为





从图 4、图 5 可以看到,在很长一个波长范围内 信频光 30 mJ 左右、闲频光 15 mJ 左右。信频光波 段的平均转换效率约 15%,闲频光的转换效率约 10%。其中闲频光在 3.3 μm 以后激光能量迅速减 弱,可解释为该波段 KTP 晶体的吸收增大导致能量 减弱,与之对应的信频光波段(1.5~1.57 μm)的能 量也相应减弱。

4 结 论

中红外可调谐激光器在光谱学及军事领域(如中波红外激光干扰)都有重要的应用价值和前景。 本文通过角度调谐 KTP – OPO 的方法首次在实验 台上实现了 1.5~3.6 μm 范围内连续波长调谐, OPO 转换效率在信频光波段 15%、闲频光波段 10%,脉冲宽度约 18 ns,为以后的基础研究奠定了 基础。

参考文献:

- T C hasenberg, et al. "Demonstration of 3.5 μm GaInSb/ InAs supperlattice laser diode" [J]. Electron. Lett., 1995,31(2):275-276.
- $\label{eq:lass} \begin{array}{l} \mbox{[2]} & A \ M \ Baranov, et al. 2. 7 \sim 3.5 \ \mu m \ InAsSb(\ P)/InAsSbP \\ & \mbox{low threshold diode laser} \mbox{[J]}. \ Appl. \ Phys. \ Lett. \ , 1994 \ , 64 \\ & \ (5): 2480-2482. \end{array}$
- Peng Ling, Ren Gang, Huang Wei, et al. Numerical analyses of the allowed parametrical errors in tunable OPO[J].
 High Power Laser and Particle Beams, 2002, 14 (6): 823 826.
- [4] W Kish Nile. Solid state laser engineering [M]. Beijing: Science Press, 2001.